

2.3 二階相干函數理論

二階相干函數（Second order correlation functions）結合 HB-T 光子相干技術可用於檢測發光源是否為單光子光源。其架構由 Hanbury-Brown 和 Twisse 提出，將於第三章中作介紹。

光子相干通常被用來量測發光體的數目。以二能階系統為例，二階相干函數表示法為 [36][37]：

$$g^{(2)}(\tau) = \frac{\langle I(t)I(\tau+t) \rangle}{\langle I(t) \rangle^2}, \quad (2-9)$$

把兩偵測器量到的光子數由下列函數表示：

$$g^{(2)}(\tau) = \frac{\langle n_1(t)n_2(t+\tau) \rangle}{\langle n_1(t) \rangle \langle n_2(t+\tau) \rangle}, \quad (2-10)$$

其中 $n_i(t)$ 表示偵測之光子數，將 $n_i(t)$ 以階梯算符 \hat{a} （Ladder operator）、厄米特共軛 \hat{a}^+ （Hermitian conjugate）代替：

$$g^{(2)}(\tau) = \frac{\langle \hat{a}_1^+(t)\hat{a}_2^+(t+\tau)\hat{a}_2(t+\tau)\hat{a}_1(t) \rangle}{\langle \hat{a}_1^+(t)\hat{a}_1(t) \rangle \langle \hat{a}_2^+(t+\tau)\hat{a}_2(t+\tau) \rangle}, \quad (2-11)$$

$$= \underbrace{\frac{(N^2-N)}{N^2}}_{\tau=0} + \underbrace{\frac{1}{N} \frac{P_e(\tau)}{P_e(\infty)}}_{\tau \neq 0}, \quad \hat{n} = \hat{a}^+ \hat{a}, \quad (2-12)$$

其中 $P_e(\tau)$ 表示時間 τ 激發態的佔有率。

(2-12) 式為 $\tau = 0$ 時， $g^{(2)}(0) = \frac{(N^2-N)}{N^2}$ ； $\tau \neq 0$ 時， $g^{(2)}(\tau) = \frac{1}{N} \frac{P_e(\tau)}{P_e(\infty)}$ 。

而當 $\tau=0$ ，(2-11) 可簡化為：

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle \hat{a}_1^+ \hat{a}_2^+ \hat{a}_2 \hat{a}_1 \rangle}{\langle \hat{a}_1^+ \hat{a}_1 \rangle \langle \hat{a}_2^+ \hat{a}_2 \rangle}, \quad (2-13)$$

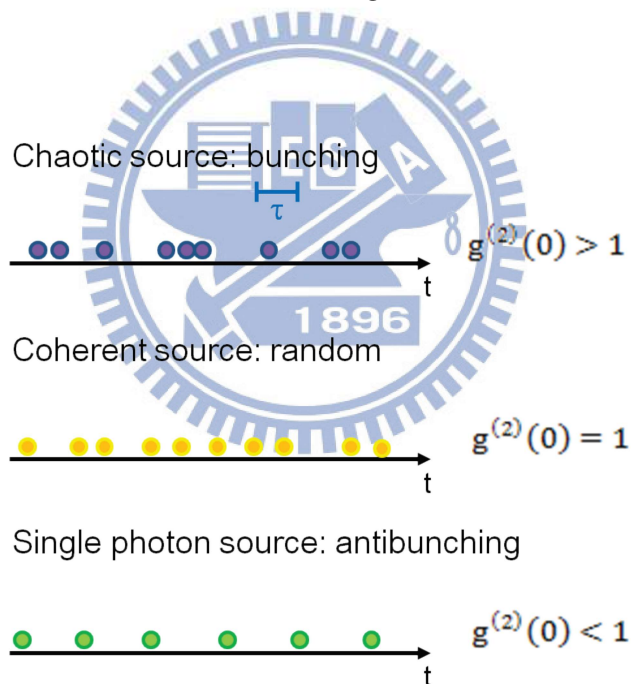
利用階梯算符可以表示成

$$\underline{g^{(2)}(0) = \frac{n(n-1)}{n \cdot n} = 1 - \frac{1}{N}}. \quad (2-14)$$

其中 N 表示發出之光子態數量。

由式子可知， $N=1$ 即所謂的單光子光源，此時的 $g^{(2)}(0)=0$ 。

簡而言之，當 $g^{(2)}(0) > 1$ 時，集束（Bunching）現象代表光子具有高度的相干性；當 $g^{(2)}(0) = 1$ 時，同調現象代表光子不具任何相干性，光源強度不因時間改變；當 $g^{(2)}(0) < 1$ 時，代表光子光源被兩偵測器同時量到的機率極低，因此，反集束（Anti-bunching）現象可以辨識單光子源，如【圖 2-10】所示。



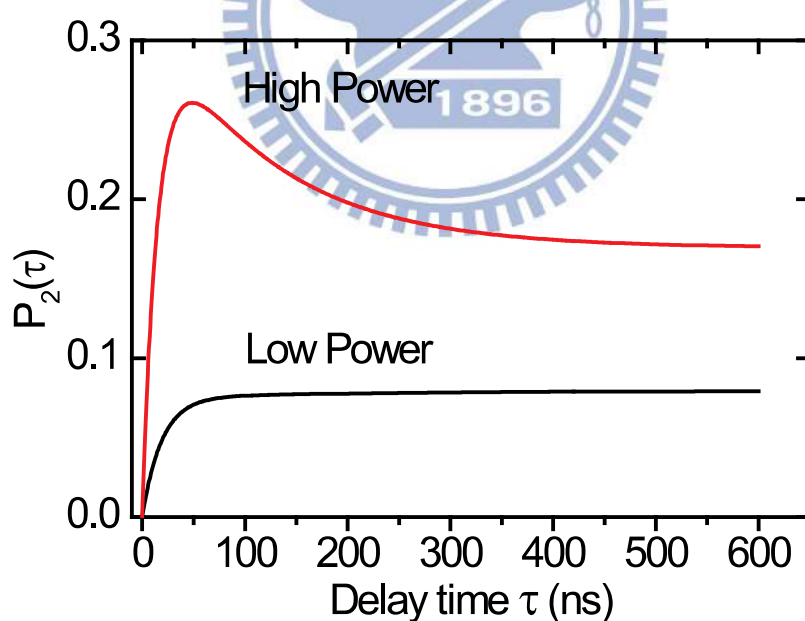
【圖 2-10】光子集束、同調、反集束現象比較。

將二階相干函數（2-12）式與 2.2.2 小節中，三能階系統動力學方程式（2-2）式結合：

$$g^{(2)}(\tau) = \frac{p_2(\tau)}{p_2(\infty)} = 1 + C_2 e^{-\frac{\tau}{\tau_2}} + C_3 e^{-\frac{\tau}{\tau_3}}. \quad (2-15)$$

在三能階系統下，電子由激發態掉到基態的速率，基本上大於由激發態掉至亞穩態。換句話說，當以低激發功率激發電子使其躍遷至激發態時，電子較易直接復合回基態，因此亞穩態對系統所造成的影響甚小；當提高激發功率時，激發態的電子數數目眾多，使其無法及時復合回基態，故電子有機會跑至亞穩態，造成集束現象。【圖 2-11】為 $p_2(\tau)$ 在高激發和低激發功率時，電子占有率對時間的結果。由圖可知，在高功率激發態占有率尚未達到穩態時間時，會有電荷累積的現象，因此， $\frac{p_2(\tau)}{p_2(\infty)}$ 大於 1，為集

束現象；低激發功率時， $\frac{p_2(\tau)}{p_2(\infty)}$ 小於 1，為反集束現象。



【圖 2-11】高激發和低激發功率時，電子占有率對時間的結果。